



睿晶科技股份有限公司
SILICON WORKS TECH CORPORATION

S SOI 规格表

长晶法	Cz, MCz,
直径	200 mm, 150 mm
晶向	<100>, <111>
N 型掺杂	磷、砷、锑
P 型掺杂	硼
电阻率	From 0.0008 to 100 Ohm-cm
器件层厚度	From 0.3 μm to 305 μm
	容许值 $\pm 0.05 \mu\text{m}$ (SSOI)
埋氧层厚度	From 0.1 μm to 6 μm
载体晶圆厚度	200 mm: 400 μm to 1000 μm
	150 mm: 400 μm to 1000 μm
背面	Polished or etched
阶梯区域	Standard or Terrace Free